

DHA<sup>®</sup>

QJ/DHA 09.27-2018

LD730

## N-沟道 MOSFET 功率晶体管

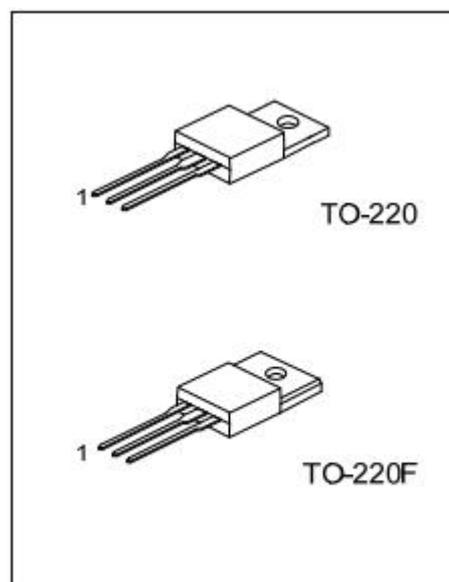
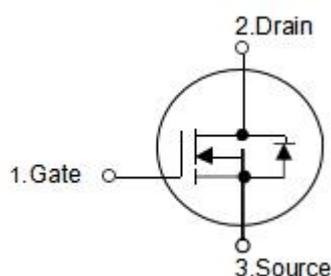
## 描述

MOSFET 为功率设计人员提供了快速开关, 低导通电阻和合理成本的最佳组合。

## 用途

该器件适用于开关模式电源, DC-AC 转换器和高电流高速开关电路。

## 等效电路图



## 电参数 (Tamb = 25°C)

缩写	参数	单位	最小值	典型值	最大值	测试条件
BV <sub>DSS</sub>	漏极-源极 击穿电压	V	400	-	-	V <sub>GS</sub> = 0 V, I <sub>D</sub> = 250 μA
I <sub>D</sub>	漏极连续电流	A	-	-	6.0	T <sub>j</sub> = 25 °C
R <sub>DS(on)</sub>	静态 漏极-源极 导通电阻	Ω	-	0.78	0.95	V <sub>GS</sub> = 10 V, I <sub>D</sub> = 3 A
V <sub>GS(th)</sub>	栅极门限电压	V	2.0	-	4.0	V <sub>DS</sub> = V <sub>GS</sub> , I <sub>D</sub> = 250 μA
I <sub>DSS</sub>	漏极-源极 漏电流	μA	-	-	10	V <sub>DS</sub> = 400 V, V <sub>GS</sub> = 0 V
I <sub>GSS</sub>	栅极-源极 漏电流	nA	-	-	100	V <sub>GS</sub> = ± 30 V, V <sub>DS</sub> = 0 V
T <sub>j</sub>	工作结温	°C	- 55 ~ +150			
T <sub>STG</sub>	储存温度范围	°C				